



7. Время наработки — 10000 час.

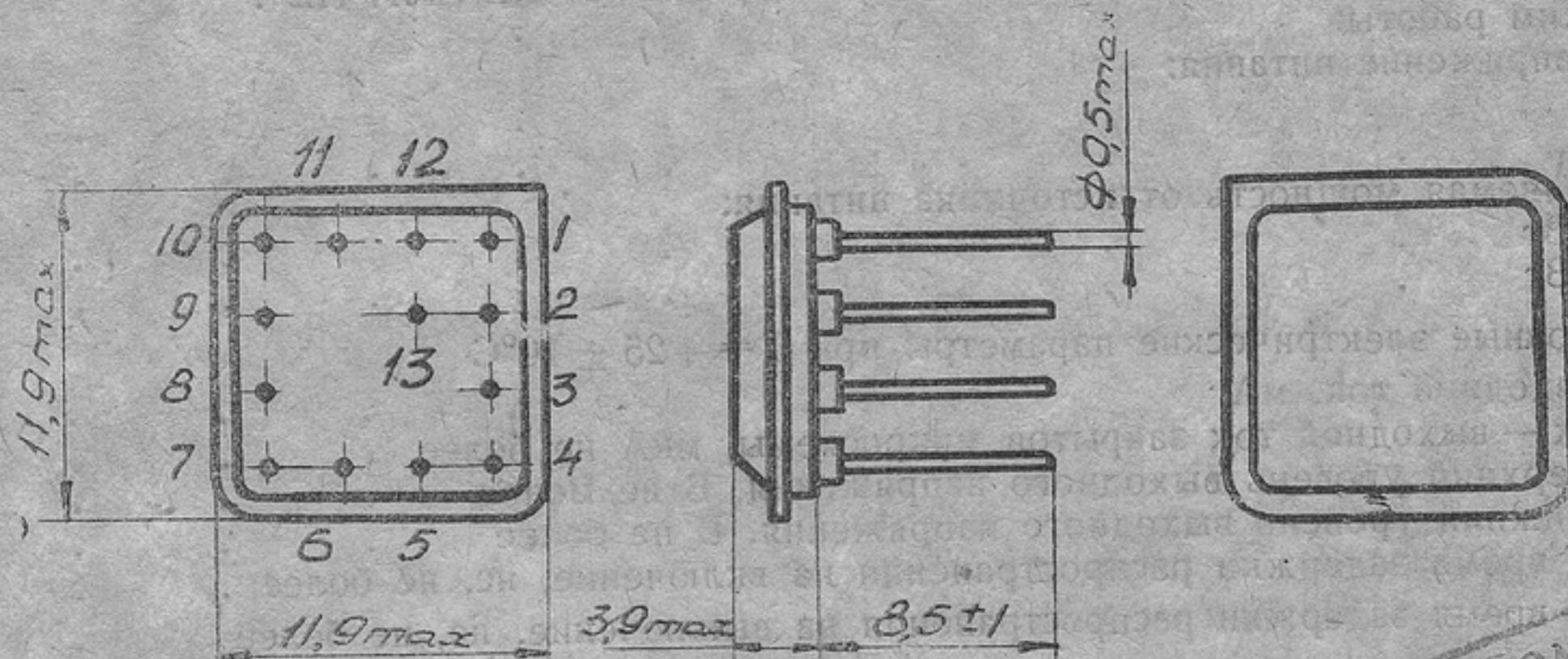
8. Срок хранения — 6 лет.

9. Гарантии предприятия-изготовителя.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие каждой поставляемой микросхемы всем требованиям ГОСТ 18725—73 и ТУ в течение срока сохраняемости или наработки при соблюдении потребителем режимов и условий эксплуатации, правил хранения и транспортирования, а также указаний по применению, монтажу и эксплуатации установленных ГОСТ 18725—73 и ТУ.

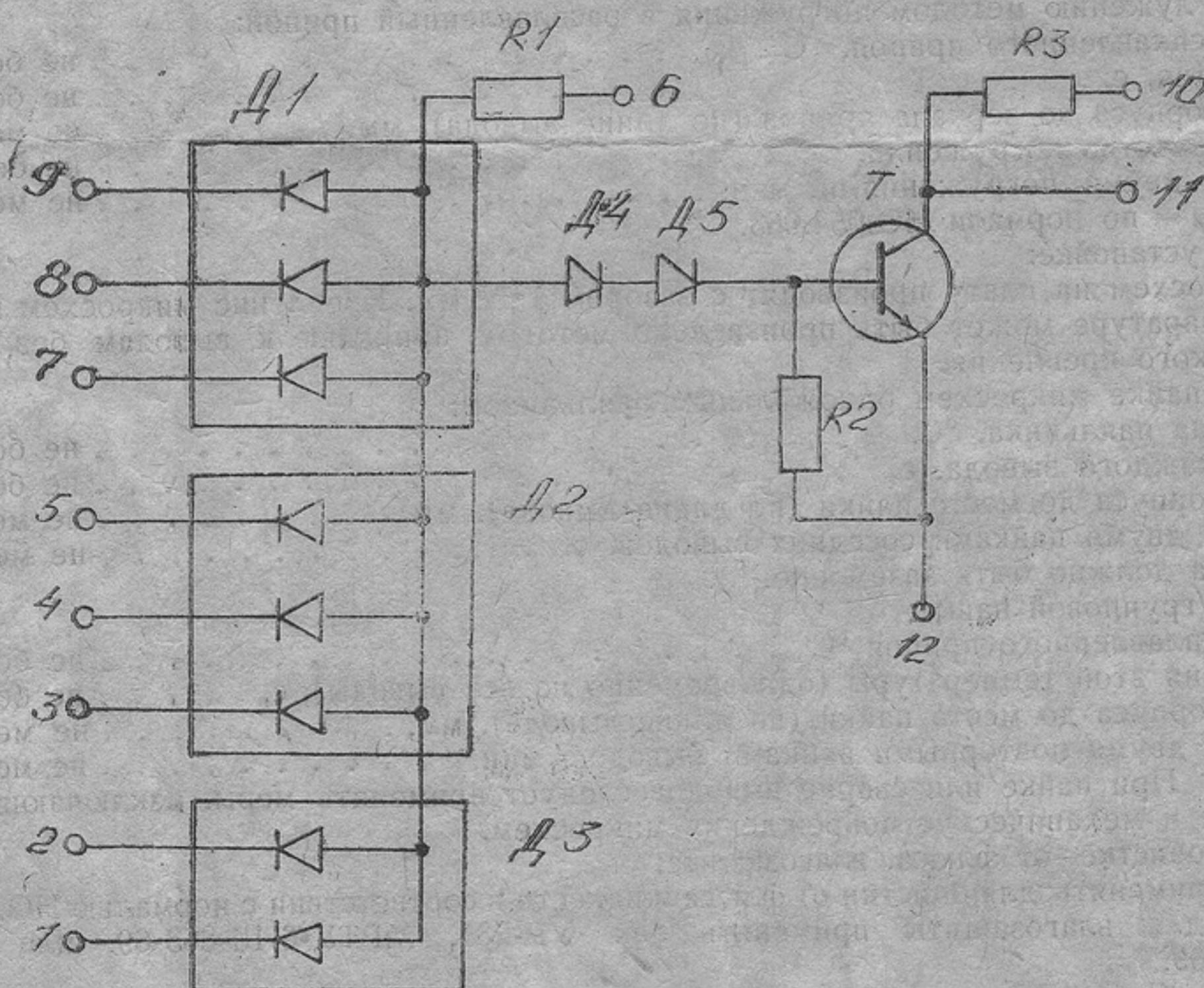
Срок гарантии исчисляется со дня отгрузки микросхем потребителю.

## ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



Масса микросхемы не более 1,5 г.

Схема электрическая принципиальная  
микросхемы 217Л51А, 217Л51Б



R<sub>1</sub> = 3,0 кОм ± 5%;

R<sub>2</sub> = 7,0 кОм ± 20%;

R<sub>3</sub> = 1,5 кОм ± 10%;

Вариант I Д-3 Диодная матрица 2Д910Б или 2Д910В

Вариант I Д1, Д2—Диодная матрица 2Д910В

Вариант I Д4, Д5—Диодная матрица 2Д910 А

Вариант I ПП1—Транзистор кремниевый 2T318Б или 2T318В

Вариант II Д1, Д3—Диодная матрица 2Д912А

Вариант II Д4, Д5—Диодная матрица 2Д912Б

Вариант II ПП1—Транзистор кремниевый 2T333Б или 2T333В

Вариант II обозначается треугольником цвета маркировки

/Дата выпуска \_\_\_\_\_

Штамп ОТК